

Транзистор 2Т831ОСМ



ОКП 63411

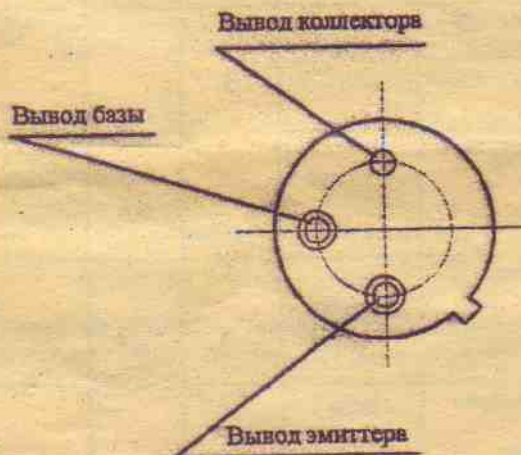
**ЭТИКЕТКА**  
**ЮФ3.365.082-02 ЭТ**

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типов 2Т831АОСМ, 2Т831БОСМ, 2Т831ВОСМ, 2Т831ГОСМ в металлокерамическом корпусе КТ-2-7 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в усилителях мощности, вторичных источниках питания, преобразователях и другой аппаратуре.

Транзисторы чувствительны к воздействию статического электричества.

Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 25486-82

**Схема расположения выводов**



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 1.1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
 при  $t_{\text{опр}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквен- ное обозна- чение	Норма		Приме- чание
		не менее	не более	
Граничное напряжение, В 2Т831АОСМ 2Т831ВОСМ 2Т831ГОСМ ( $I_k = 0,1\text{A}$ , $Q \geq 100$ , $T_n \leq 300\text{мкс}$ , $\Delta t_{\text{изм}} \geq 50\text{мкс}$ , $U_{\text{кз огр}} = 95 \pm 10\%$ )	$U_{\text{кз огр}}$	25 45 60 80		
Пробивное напряжение коллек- тор-база, В 2Т831АОСМ 2Т831ВОСМ 2Т831ГОСМ ( $I_k = 0,1\text{mA}$ )	$U_{\text{кзо проб}}$	35 60 80 100		
Пробивное напряжение эмиттер- база, В 2Т831АОСМ+2Т831ГОСМ ( $I_z = 1\text{mA}$ )	$U_{\text{ззо проб}}$	5		
Напряжение насыщения коллек- тор-эмиттер, В 2Т831АОСМ+2Т831ГОСМ ( $I_k = 1\text{A}$ , $I_b = 0,1\text{A}$ )	$U_{\text{кэ нас}}$		0,6	
Напряжение насыщения база- эмиттер, В 2Т831АОСМ+2Т831ГОСМ ( $I_x = 1\text{A}$ , $I_b = 0,1\text{A}$ )	$U_{\text{зэ нас}}$		1,3	
Статический коэффициент пере- дачи тона 2Т831АОСМ+2Т831ВОСМ 2Т831ГОСМ ( $U_{\text{кз}} = 1\text{В}$ , $I_z = 1\text{A}$ )	$h_{21э}$	25 20		

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото 1,045 г.

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 100 000 ч.

2.2 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или во всех местах хранения приборов, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

При хранении приборов в упаковке изготовителя или смонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом, а также на открытой площадке минимальный срок сохраняемости должен соответствовать значениям, приведенным в таблице.

Место хранения	Минимальный срок сохраняемости, годы	
	в упаковке изгото- вителя	в составе незащищен- ной аппаратуры и ЗИП
Неотапливаемое хранилище	16,5	16,5
Навес	12,5	12,5
Открытая площадка	Хранение не допускается	12,5

Примечание. Минимальный срок сохраняемости приборов в специальной упаковке изготовителя при хранении в зонах тропического климата - 8 лет.



### 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям АА0.339.140ТУ, ПО.070.052 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и ТУ на изделия.

Гарантийный срок - 25 лет с даты изготовления приборов, а в случае перепроверки - с даты их перепроверки.

Гарантийная наработка:

100 000 ч. - в режимах и условиях, допускаемых ТУ.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

### 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т831АОСМ, 2Т831БОСМ, 2Т831ВОСМ, 2Т831ГОСМ соответствуют техническим условиям АА0.339.140ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 1 от 5.03.02  
дата

Место для штампа  
ОТК



Место для штампа  
представителя заказчика



Место для штампа "Перепроверка произведена" \_\_\_\_\_  
дата

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
дата

Место для штампа  
ОТК

Место для штампа  
представителя заказчика

Цена договорная